文章编号: 1006-3471(2006) 01-0016-004

## 纳米 $TD_2$ 电极的特殊光电化学响应

蓝碧波,周剑章,席燕燕,陈红香,姚光华,林仲华\* (厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室,厦门大学化学系,福建厦门 361005)

摘要: 应用涂膜法、电沉积法和溶胶-凝胶法制备纳米 TO,电极.实验发现,纳米 TO,具有特殊的光电化学 响应. 其光电流 ~ 电位变化出现光电流峰. 这一特殊的光电化学性质 乃与纳米半导体电极的纳米结构及其特 殊的光诱导氧化还原反应机理密切相关.

关键词: 纳米 T 10,电极; 光电流~电位响应; 光电化学

中图分类号: 0 646 0 482

由于纳米 TO2电极具有庞大的比表面和许多 优异的性质。在光电化学太阳能电池、光催化、化学 电源和燃料电池等领域具有广泛的应用<sup>[1-2]</sup>.纳米 半导体电极是由纳米粒子组成的多孔性电极,溶液 可以渗透到电极的每个纳米粒子以及基底上,自从 Gratzel报道了经染料敏化的TO<sub>2</sub>多孔光阳极以来,纳米 T O<sub>2</sub>电极的研究非常活跃.它具有与一般 半导体不同的光电化学响应<sup>[3-4]</sup>. 在传统块体 TO<sub>2</sub> 半导体电极的光电流~电位变化关系中,从平带电 位开始产生光电流,并且迅速达到饱和,本文分别 应用涂膜法、电沉积法和溶胶-凝胶法制备纳米 TO2电极.实验发现纳米 TO2稳态光电流~电位变 化关系不同于块体理想半导体,与作者以往的研究 类似<sup>[3]</sup>,结合暗态极化曲线,进一步探索其产生原 因

实验部分 1

1.1 纳米 T O<sub>2</sub>电极的制备方法

1)涂膜法制备:在适量无水乙醇中分散 TO<sub>2</sub> 粉末 (from Aldrich) 成悬浊液. 依次用丙酮、无水乙 醇和三次水超声清洗导电玻璃(IID). 然后将 TO, 悬浊液均匀地涂在清洗过的 IFO 上,即得纳米 TO2电极 I 粒径约为 150 nm.

2) 电沉积法制备: 用 NaOH 调节三氯化铁溶液 的 pH值至 2 2,将清洗过的 IFO 电极放入三氯化

文献标识码: A

钛溶液, 恒定电位 + 0.1 V 阳极极化 30 m in 便可 在 ITO 上形成钛()水化膜,清洗后室温干燥,置 于红外干燥箱中干燥 20 m in 再于马福炉中 450℃ 空气氛中恒温 0 5 h 然后冷却至室温, 即得纳米 TiO2电极 , 粒径约为 30 nm

3)溶胶-凝胶法制备: 以乙酞乙酸乙醋作保护 剂,水解钛酸四丁酯,得到 TO2透明溶胶,使用提 拉法将透明溶胶转移到清洗过的 IIO 上, 放在红外 干燥箱中干燥 20 m in 再于马福炉中 450 ℃空气氛 中恒温 0.5h 然后冷却至室温, 即得纳米 TO<sub>2</sub>电 极班, 粒径约为 30 nm

#### 1.2 仪器及实验条件

使用自行研制的联用系统作光电化学测量,电 解池为带石英窗口的三电极电解池,工作电极为纳 晶 TiO2电极, Pt电极为对电极, 饱和甘汞电极 (SCE)为参比电极. 文中所指电极电位均相对于 SCE. 电解质为 0. 2 mol/L Na<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>溶液. 使用恒电位 仪 (Model 273 EG&G PARC)分别作控电位或电位 扫描的光电化学测试、以 200 W 氮灯为光源、入射 光经单色仪控制波长后,光斩波器 (Model 194 EC&G PARC, 频率为 30 Hz) 调制, 照射到工作电 极,用锁定放大器 (Model 5206 EG&G PARC)检测 光电流作用谱和光电流~电位变化曲线,实验数据 用计算机采集处理.

收稿日期: 2005-09-07 \* 通讯作者: Tel (86-592)2189663, E-mail zhlin@ xmu edu cn 国家自然科学基金 (20373057,20433040)资助

室温(20℃)下实验,所用试剂均为分析纯.

#### 2 结果和讨论

图 1是分别用涂膜法、电沉积法和溶胶–凝胶 法制备的 TO<sub>2</sub>在 0 2 mol/L N  $_{28}$  SO<sub>4</sub>溶液中的光电 流谱图. 由图可见, 除了起动能量有所差别外, 3种 方法制备的 TO<sub>2</sub>的光电流谱的光谱范围基本相 似.



- 图 1 不同方法制备的 T O<sub>2</sub>在 0 2 mol/L N a<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>溶液中控 电位 800 m V 的光电流谱图 a)涂膜, b)电沉积, c)溶胶-凝胶法
- Fig 1 Photocurrent spectra for the T  $D_2$  prepared with different methods in 0,  $2\,m\,ol/L$  N  $a_2\,SO_4$  solution at 800 mV a) spreaded b) electrodeposited c) sol-gel

图 2~图 4分别给出以上 3种方法制备的纳 米 TO<sub>2</sub>电极的光电流~电位变化关系和暗态极化 曲线 (扫速 0 8 mV/s).显然,由 3种方法制备的 TO<sub>2</sub>其产生的光电流都为阳极光电流,并且随着电 位正移光电流先是迅速增大,至极大处出现光电流 峰,然后衰减下来,变化平缓.作者认为,这一不同 于块体理想半导体的光电响应乃与构成纳米半导 体电极的纳米颗粒的光电性质及其光诱导氧化还 原反应机理的特殊性有关.

由于纳米半导体粒子能带基本不弯曲, 很难形 成空间电荷区, 其光生电子和空穴通过扩散到达微 粒表面, 电荷分离主要受半导体 熔液界面的动力 学控制. 又因电解质可穿透到 IIO 导电层上的整个 微粒膜, 每个半导体微粒都能够和溶液发生接触, 光照时, 半导体微粒吸收光, 产生电子、空穴对, 并 扩散到微粒表面, 此时, 若还原物种捕捉空穴速率 较快, 就会产生阳极光电流, 反之, 产生阴极光电



- 图 2 涂膜法制备的纳米 T O<sub>2</sub>电极在 0 2 mol/L N a<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> 溶液中于白光照射下的光电流~电位变化 (a)和暗 态极化曲线 (b)
- Fig 2  $I_{\rm ph} \sim E$  curve under illuination (a) and polarization curve under dark (b) for the nanocrystalline T $iO_2$ electrode prepared by spreaded in 0. 2 mol/L Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution



- 图 3 电沉积法制备的纳米 T iO<sub>2</sub>电极在 0 2 m ol/L N a<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>中 于白光照射下的光电流~电位变化 (a)和暗态极化曲线(b)
- Fig 3  $I_{\rm ph} \sim E$  curve under illuination(a) and polarization curve under dark(b) for the nanocrystalline TO<sub>2</sub> electrode prepared by electedposition in 0.2 m ol/L Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution

流.可见,依照溶液中氧化还原电对捕捉空穴和电 子之速率快慢,每个独立的半导体微粒和整个纳米 电极都可能产生阳极或阴极光电流,呈现 n型或 p 型半导体的性质<sup>[1]</sup>.对 N  $_{2}$  SO<sub>4</sub>溶液,存在 H<sub>2</sub>O/H<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O 电对,相较其标准电极电位,纳米 TO<sub>2</sub> 电极的价带电位正于 O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O 的幅度远大于导带

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



- 图 4 溶胶-凝胶法制备的纳米 TO<sub>2</sub>电极在 0 2 m ol/L N a<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>溶液中于白光照射下的光电流 ~ 电位变化 (a) 和 暗态极化曲线 (b)
- Fig 4  $I_{\rm ph} \sim E$  curve under illuination(a) and polarisation curve under dark (b) for the nanocrystalline TO<sub>2</sub> electode prepared by sol-gel in 0.2 m ol/L Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution



电位负于 H<sub>2</sub>O /H<sub>2</sub>的幅度. 于是光生空穴即被还原 物种 H<sub>2</sub>O分子捕捉, 生成 O<sub>2</sub>分子, 又因储荷效应的 作用,光生电子在 TO2 微粒和导电玻璃的导电层 之间出现浓度梯度,并驱动电子通过导电玻璃流向 外电路, 形成阳极光电流 (见图 5). 然而, 与块体理 想半导体显著不同的是,电极电位正移,光电流反 而衰减下来. 由图 2h 图 3b和图 4b显示的暗态极 化曲线可见,在光电流开始衰减的电极电位附近, 阳极电流显著增大,有较多的氧化物种开始产生, 生成的氧化物种可捕捉光生电子,从而降低了流过 外电路的光电流. 电位越正, 一方面, 导电层 溶液 和 TO<sub>2</sub> 溶液界面电位较正, 有利于电子、空穴对 的分离:另一方面又有利于氧化物种产生,其捕捉 光生电子的作用也越强,致使流过外电路的光电流 下降, 二者制约的结果导致出现图 2 图 3和图 4 中的光电流~电位变化曲线出现了于光电流峰之 后的起伏衰减波形.

### 参考文献 (References):

- [1] Hagfeldt A, GnatzelM. Ligh+induced redox reactions in nanon ystalline Systems [J]. Chem. Rev., 1995, 95, 49
  ~ 68
- [2] Hoffmann M R, Martin S T, Bahnemann D W, et al Environmental application of sem iconductor photocatalysis[J], Chem. Rev., 1995, 95, 69.
- [3] Luo Jin (罗瑾), Su Lian-yong (苏连永), Xie Lei(谢 雷), et al Studies on photoelectrochem ical behavior of nanocrystaM ne T O 2 film [J]. Acta Phys. Chin. Sin, 1998, 14: 315~319
- [4] Lv Hong-hui(吕红辉), Wen Zi(文子), Liu Yan-mei (刘艳梅), et al The effect of the suface state of TO2 nanoparticles on the photocurrent response[J]. A cta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis, 2001, 2, 95 ~ 98.

- 图 5 光照下于 T D<sub>2</sub>微粒上发生的反应(a)和 T D<sub>2</sub>微粒 n 型半导体响应(b)示意图
- Fig 5 Schematic diagrams of reactions occurred on the TO<sub>2</sub> particles(a) and n-type semiconductor response of the nanocrystalline TO<sub>2</sub> films(b)

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# Special Photoelectrochem ical R esponse of N ano-crystalline T $O_2$ E lectrode

LAN Bibo, ZHOU Jian-zhang XIYan-yan,

CHEN Hong-xiang YAO Guang-hua, LN Zhong-hua<sup>\*</sup>

(StateKey Laboratory of Physical Chen istry of the Solid Surface, Department of Chenistry, X iam en Universty, X iam en 361005, Fujian, China)

Abstract The nano-crystalline T $\dot{D}_2$  electrodes were prepared by spread method, electrodeposition and sol-gel method. The experimental results show that the nano-crystalline T $\dot{D}_2$  electrodes have special photoe lectrochem i cal response-the photocrrent-potential curves appear peaks. The special photoe lectrochem ical behaviors of nano-crystalline T $\dot{D}_2$  electrodes are ascribed to nano-structure as well as special light induced redox reaction mechanism of nano-crystalline sem iconductor electrodes.

Keywords Nano-structured TO2 electrodes, Photoeurrent-potential response, Photoelectrochem istry